本练习指导用户改进电子机箱的表示,请完成以下步骤:

- 1. 用离散元件替代 PCB 中元件的均匀表示。
- 2. 增加辐射热传递处理
- 3. 求解和分析结果。

练习 4 - 模型改进						
Load (读取) "Tutorial 3"并将它保存为"Tutorial 4"。						
名称设为"Refined model of the set top box"。						
在改进 set-top box (置顶盒)模型的过程中,我们对练习 3 中的 PCB						
板和元件进行更加详细的建模。						
在 PM(项目管理器)中,对名为"Electronics"的组件和简单部件						
"PCB 1"进行扩展。将 PCB 板的名称由"PCB 1:0"改为"PCB 1"。						
删除位于 PCB 1 上的元件"Component"。						
我们现在要定义此'Apply over board'热源并将它建模为独立的元件,						
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
选中"PCB 1",点击'Component'简单部件图标 🔷 ,此图标在调色板						
中(可通过热键 F7 或点击图标 打开调色板)。						
 右键点击此元件进λ'Construction' 茎单 并更名为"Comp1"						
石键点山此几件近八 Construction 来半。开史石为 Compi 。						

练习 4 - 模型改进
为此元件分配一个 7.0 瓦的功率。 定义位置: Xo=35mm Yo=30mm 选择'Top' (位于 PCB 板上部);尺 寸: Xo=25mm, Yo=25mm, Zo=7mm.。 将'Modeling Option'选项设为'Discrete' 并选择'Solid Component'。 在'Component Material' 项中点击'Material' 并在弹出的窗口中点击 'New'创建一种新的材料。.

练习 4 - 模型改进									
集为4-7 定义这种材料的名称为"Lumped Chip"并给它一个'Constant'(恒定 的)热传导系数值 20W/mK。 点击'OK'退出此对话框并在'Material Selection'列表中选中"Lumped Chip"点击'Attach',将这种材料应用于元件"Comp1"。 点击'OK'退出 'PCB Component'对话框。					·个'Cons 列表中 <i>进</i> mp1"。	tant'(竹 章中"Lun		Material Property Name: Lumped Chip Notes EM Thermal Orthoutopic © Donstant © Temperature Dependent Orthoutopic Conductivity 2.000000e+001 W/(m K) ♥ Electrical Resisitivity © Constant © Temperature Dependent Resistivity 0.000000e+000 Dhm m ♥ Density 1.000000e+000 kg/m^3 \$ \$ Specific Heat 1.000000e+000 J/(kg K) \$	
依上述步骤,在"PCB1"上创建以下元件:							1	Material Selection	
РСВ1	热功 耗 (W)	位置 (mm) 尺寸 (mm)				く寸 (mm	1) 70	-	Steel (Mid) Copper (Pure) FR4
General	3.5	0	0	Тор	190	210	5		
Comp 2	0.5	35	105	Тор	20	20	2		
	生成一	-个2x2	的阵列棒	莫型,Pitch	(间距)为	: Xo = 4	0 mm,		Libray
Comp 3	1.0	130	35	$T_{op} = 35 \text{ mm}$	20	20	4		
Comp 4	1.5	130	65	Тор	25	25	2	1	Lumped Chip
备注:	-	•		•					Currently Attached
1. "General" 是 'Apply over board' (均布于整个板).所有其它的元件都						す其它的		Lumped Chip	
是 'Discrete'和'Solid'。								Dismiss Attach Help	
2."General"不需要材料属性。其他元件都要应用"Lumped Chip"材料属						d Chip"			
3. 使用 Patt	ern(复制)选项为"	Comp2"	<u> 刘建一个 2</u> :	x2的元作	丰阵列。			



练习 4 - 模型改进						
在PM中,展开"Structure"组件。 右键点击"Chassis",进入'Construction'菜单。将'Modeling Level'项从 'Thin'(薄)改为'Thick'(厚)。	模型改进					
在 PM 中,选中 PCB1 下的"Comp1"并在调色板中点击'Monitor Point' (监控点)图标 ◆?。 右键点击'Monitor Point',进入'Location'菜单将其更名为 "MB_Comp1"。	此监控点位于"Comp1"的中心,用于监控这一元件的温度。一般来 说,监控点设在系统中最重要的元件内。这样,可以使用户能够动态 的跟踪求解过程以确保其逼近合理值。					





练习4-	模型改进
回到 PM 中, 扩展'Model'。右键点击'Modeling'并选择'Input'。 在 Radiation 项的三个可选项中,选择'Radiation On',引入模型的辐射。 同时,选中'Store Surface Temperatures'(保存表面温度)。 点击'OK'退出此对话框。	Global Units Unit Class: TIME VELOCITY VOLFATE VOLOTAGE VOLUME Use Unit: Dismiss Leop

练习4-模型改进							
在"Structure"组件中,右键点击"Chassis",进入'Radiation'。	Radiation Selection						
点击'New'创建一个新的辐射属性。	Sub-divided 100mm						
将这一属性命名为"Sub-divided 100mm"。	Сори						
在'Surface'项中选择'Sub-divided Radiating'并输入值 100mm 作为其 'Subdivided Surface Tolerance'。							
点击'OK'退出此对话框。	Sub-divided 100mm						
通过将窗口底部的'Attachment'项设置为'Default All'并点击'Attach'可将这种属性应用于箱体的各个面。	Currently Attached						
将同样的辐射属性应用于两个 PCB 板。	Attachment Applied To Default All ◆						
现在,'Exchange Factor Calculator'(转换系数计算器) 了。 点击它开始辐射角度计算。 计算结束,点击 ¹⁰⁰ 运行标准 CFD 求解器。再次对考虑辐射的情况求 解。	Dismiss Attach Help 备注: 'Sub-divided Radiating' 所指的表面辐射不是均匀的,而是考虑 了每 100m 范围的空间温度变化。						



练习 4 - 模型改进									
与前面一样,注意察看以下信息:	Erojec	ables - FLOTHERM 4.1 ct Edit Yjew Icols Dpi	ions Eyternal	Window				 #	eb
1.对于 PCB1 上的"Comp1",纪录 Y-low 面的 surface-surface 温度。		a 😡 🚺 🖧 * 1	17 Da 14	踏噌峭 ⇔ ↔	≜ №				
最小温度 Min. Temp.: °C		Cuboid Fluxes POB 1	Face	Min. S-F Surface Temperature (deg C)	Max, S-F Surface Temperatuze (deg C)	Mean S-F Surface Temperature (deg C)	Min. S-S Suiface Temperature (deg C)	Max. S-S Suilace Temperature (deg C)	-
最大温度 Max. Temp.:℃		ConductingBoard ConductingBoard	X-High X-Low	52.752 55.63	65.344 77.975	59.713 66.482	0 0	0	
平均温度 Mean Temp.:℃	♦ h	ConductingBoard ConductingBoard ConductingBoard	Y-High Y-Low Z-High	52,563 52,464 64,917	96.826 79.26	64.418 64.90 71.712	0	0	
以及	1	Comp1 Comp1 Comp1 Comp1	X-High X-Low Y-High	116.93 117.59 118.12	118.88 119.44 119.46	118.28 118.9 119.12	0 0 0	0	
2.		Comp1 Comp1	Y-Low Z-High Z-Low	0 116.93 117.69	0 118.72 119.36	0 118.08 118.79	116.39 0 0	1181 0 0	
流入系统的流量:		Comp2 Comp2 Comp2	X-High X-Low Y-High	68.7 68.718 68.639	69.195 69.219 69.221	69.071 69.094 69.089	0 0 0	0 0 0	
流出系统的流量:	ě	Comp2 Comp2 Comp2	Y-Low Z-High Z-Low	0 63.196 68.699	0 69.224 68.72	0 69.217 68.715	60.636 0 0	69.182 0 0	
将上述结果与不考虑辐射场时计算所得的结果进行比较。		Comp2 Comp2 Comp2	X-High X-Low Y-High	64.526 64.5	65.02 65.027 65.029	64.774 64.792 64.789	0 0	0 0 0	
		Comp2 Comp2 Comp2	Y-Low Z-High Z-Low	0 65.021 64.505	0 65.03 64.531	0 65.027 64.525	64.438 0	64.988 0	
		Comp2	×High	67.967	68.4	68.292	0	0 1	-
		Name: Tutorial 4			Title: Refined model of the	set top box			